# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-127816

(43) Date of publication of application: 30.05.1991

(51)Int.Cl.

H01L 21/027 G11B 7/125

G11B 7/14

(21)Application number: 01-267575

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

13.10.1989

(72)Inventor: TSUKAMOTO TAKEO

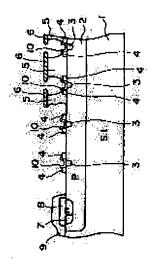
WATANABE NOBUO OKUNUKI MASAHIKO

### (54) MULTIPLE ELECTRON SOURCE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To easily irradiate a moving article with an electron beam through a simple improvement by so setting an arraying direction of electron sources disposed along a longitudinal row as not to cross the arraying direction of electron sources disposed along a lateral row.

CONSTITUTION: The arraying direction of electron sources 3 disposed along a longitudinal row is so set as not to cross the arraying direction of electron sources 10 disposed along a lateral row. Thus, since the lateral and longitudinal directions of the matrixlike sources 3, 10 disposed on a board 1 are not perpendicularly crossed, if a moving article is continuously radiated with an electron beam from the sources 3, 10, the entire sources 3, 10 of one row can be sequentially driven (linearly and sequentially drive) under a pure control within time moving the article between the source 3 and the adjacent source 10. Thus, continuous electron beam irradiation region is formed by simple means, and signal setting for control is simplified, and further a control circuit is simplified due to the simplification.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特 許 出 願 公 閉

#### 平3-127816 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月30日

H 01 L 21/027 G 11 B

8947-5D Α

8947-5D 7013-5F 7013-5F

H 01 L 21/30

3 4 1

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

マルチ電子源 60発明の名称

> ②特 願 平1-267575

22出 願 平1(1989)10月13日

塚 夫 個発 明 者 本 健 個発 明 者 渡 辺

侰 男

@発 明 者 奥 貫 昌 彦 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

キヤノン株式会社 の出 願 人

個代 理 弁理士 福森 久夫

时 新田 福祉

1. 発明の名称

マルチ電子概

2. 特許請求の範囲

それぞれ電子ピームを放出する多数の電子源を 挺列および横列のマトリクス状に基板上に配置 し、射出された電子ピームを被照射体に照射すべ く各前記電子源を順次駆動するようにして成るマ ルチ電子源において、前記艇列に沿う前記電子源 の配列方向と前記機列に沿う前記電子源の配列方 向とを直交させないように設定したことを特徴と するマルチ質子源.

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、例えばレジスト描画用装置、電子 ピーム記録用装置等のように、例えばショット キー型半導体電子額から放出する電子ピームを用 いて微細かつ高密度の電子ピーム照射を行なう べく使用されるマルチ電子源に関するものであ

#### [従来技術]

従来、この種のマルチ電子源としては、例えば 米国特許第4259678号明細書、米国特許 4303930号明細書に記載されているような ものが知られている。これによると、マルチ電子 源は、多数の電子源が縦列および横列のマトリク ス状に基板上に配置され、各前記電子源を順次ー 方向に駆動するようにして成り、各電子源の横の 配列方向(×方向)と縦の配列方向(y方向)と のなす角度が直交したいわゆる単純マトリクスで 配置した構成となっている。

#### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記従来技術の構成では、×方 向とy方向とのなす角度が直交しているので、例 えば被照射体たる移動物体に向けて各電子源から 電子ピームを放出する場合、電子ピームを移動物 体上で連続的に照射させるようにしようとする と、各電子源は固定されていることから、移動物 体の移動距離に応じて各電子源を一個ずつ個別に 制御(いわゆる点順次駆動制御)しなければなら ない。換言すれば、従来技術の構成は、 制御用に 読み込ませるデータが多岐になること、電子ピー ムの放出制御が複雑であること、電子ピームの放 出のタイミング的余裕度が極めて制約される等の 問題があり実用性に乏しいものである。

本発明は、簡単な改良を加えることにより、特に移動物体に対する電子ビームの照射を容易に行なえるようにしたマルチ電子源を提供すること目的とする。

#### [課題を解決するための手段]

上記目的を達成すべく本発明は、それぞれ電子ピームを放出する多数の電子類を擬列および横列のマトリクス状に基板上に配置し、放出された電子ピームを被照射体に照射すべく各前記電子源を順次駆動するようにして成るマルチ電子源において、前記縦列に沿う前記電子源の配列方向と前記横列に沿う前記電子源の配列方向とを直交させないように設定したことを特徴とする。

[作用]

基板上に配置されたマトリクス状電子版の検列

3

は、配線用の階段状に形成された板状電極 4 が各 イオン注入領域 2 と交叉するように、すなわち級 方向(各 y 方向 a、 b、 c、 d ··· )に形成されて いる。したがって、各 y 方向 a、 b、 c、 d ··· に おける各高濃度イオン注入領域 3 を結ぶ線と各 x 方向 A、 B、 C、 D ··· における各高濃度イオン注 入領域 3 を結ぶ線とのなす角度は直交していない ( X 方向に沿う線( X - X 線)と Y ' - Y '線と のなす角度 θ は 9 0 度よりも小である)。

さらに、前記イオン注入領域2上には、前記高 濃度イオン注入領域3から放出された電子を上方 に案内するべく脚状の電極5を介して平屋根状の 電極6が形成されている。

各前記イオン注入領域2の講郎の表面郎にはモれぞれ高機度拡散層7が形成され、各高濃度拡散層7上にはオーミックコンタクト部8が夫々形成され、各オーミックコンタクト部8上には電極9がそれぞれ接続されている。また、各前記板状電極4の講郎にはそれぞれ電極11が接続されている。

方向と縦列方向とが直交しないので、各電子源から移動物体上に遠続的に電子ピームを照射する場合、移動物体が一つの電子源とこれに隣接する電子源との間を移動する時間内に、一の列の全部のマトリクス電子源を次々と駆動(線順次駆動)させるという単純な制御で行なえる。

#### [実施例]

4

従って、マトリクス状に配列された各電子源は、各×方向A、B、C、D…の所定の電極9と各y方向a、b、c、d…の所定の電極10との間に逆パイアス電圧を印加すると、該両電極の交点位置にある電子限である高濃度イオン注入領域3がON状態となってアバランシェ増幅が生じ、当該高濃度イオン注入領域3からスポット状の電子が放出される。

なお、本実施例では電子顔としてショットキー型半導体電子顔を用いているが、特にショットキー型半導体電子顔である必要はなく、PN接合、NEA(負の電子観和力)等の各種の半導体電子源を用いることが出来る。

次に、本実施例により電子ビームを移動物体に 照射し、連続的なビーム照射領域を形成するため の手順につき述べる。

まず、電子ビームが照射されるべき領域をマトリクス電子源に対向した位置に置く。この場合、例えば×方向Aの電極2と各y方向a,b,c,d...の電極4との交点位置の電子源をON状態に

するかOFF状態にするかは予め何らかの方法で 決められており、電極2と各y方向 a, b, c, d…の電極4との間への逆パイアス電圧印加によ り、×方向Aの各電子源から順次電子放出が生じ る。

次に同様な方法で他のX方向B, C, D…の電極2と各y方向a, b, c, d…の電極4との間への逆パイアス電圧印加によりそれぞれ線順次駆動する。

全部のマトリクス位置の電子競を駆助し終えた 後に、一の電子概とこれに隣接する他の電子概と の間の距離だけ移動物体を従前の移動方向と多く する方向に多り度の方向に移動させ、再び各メスト 向A、B、C、D…と各ソ方向a、b、c、d… との交点位置の電子概を順次駆動する。かかる電 子概駆動を繰り返すことにより、移動物体の被照 射面を電子ビームにより全面照射することができ

第4図は、マルチ電子源を電子ビームメモリに 適用した場合を示している。12は上記第1の実

7

第5 図は、マルチ電子版を電子ビーム指面装置に適用した場合を示している。同図において、マルチ半導体電子版1 2 は上記第1 の実施例で述べたと同様な構成のものである。1 9 は半導体ウェハーであり、20 はレジスト上に揺かれた電子ビーム照射組成である。

前記マルチ電子源12の駆動手順は上記第2実施例とほぼ同様であるが、該電子源12の駆動制

施例で述べたと同様な構成のマルチ半導体電子 源、13はフォトダイオード、14は光を真空容 器へ入れるための導入部、15は光信号を送るた めのファイバー、16は高圧電源、17は電子 を駆動させるための電源、18は電子線配録媒体 である。該記録媒体18としてはSiのMOS構 造、アモルファス状のSiOz構造、A41Os 膜およびSiN膜等の多層膜構造のものがある。

上記のように構成されているので、マルチ電子 想12の駆動用の制御信号は、搬送クロックと同 時に多重させ光信号として光ファイバー15を介 して伝達され、フォトダイオード13で再び電気 信号に戻される。マルチ電子源12は高圧電源 16が接続されることにより高電圧になっている が、制御信号は光媒介としており、電気的に絶縁 されているので耐ノイズ性に優れている。

マルチ電子源12の光制御信号は、フォトダイ オード13で電気信号に変換され電気制御信号と しての復調制御信号となる。該制御信号はマルチ

8

御はウェハー19のステージ移動に応じ、揺画すべき全エリアにおいて電子源12を順次線駆動を行う。

### [発明の効果]

以上のようで本発明によれば、それぞれ電子でしたを放出する多数の電子源を縦列および横列のマトリクス状に基板上に配置し、放射に電子でした。放射に電子では、放射に関するように関ができるがでは、対対に対対に対対に関するでは、対対に対対に対対ができるがでは、対対は対対を形成できると共には対対の関係が、対対は対対を形成できると対対により制御の路が、はいるにとができる。

さらに、マルチ電子源をマトリクス状に構成して順次線駆動するため、移動体に同一の電子ビームの開射領域を形成しようとする場合、電子環が 一次元配刊である場合に比べて、移動体の移動速 度を低下することができ、 該電子ビームの照射領域が楕円変形するのを小さくすることができる。また、電子ビームの照射領域を連続かつ高密度で形成できるので、電子線メモリ、 揺回装置の他、電子線ブリンター等の広範囲の応用が可能となる。

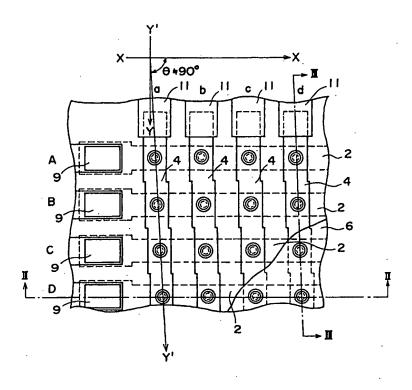
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第3図は本発明の一実施例を示すものであり、第1図はマルチ電子源の平面図、第2図は第1図のIIーII線に沿う断面図、第3図は第1図のIIIーII線に沿う断面図、第4図は電子ビームメモリ装置への応用例を示す平面図、第5図は電子ビーム揺園装置への応用例を示す平面図である。

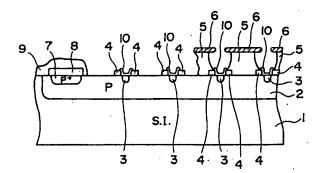
1 … 基板、 3 … P 型高濃度イオン注入領域(電子源)、 1 0 … ショットキー電板(電子源)、 1 2 … マルチ電子源。

1 1

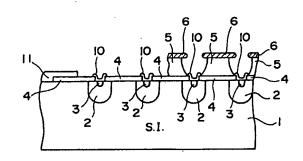
第 1 図



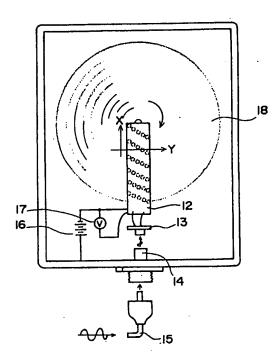
第 2 図



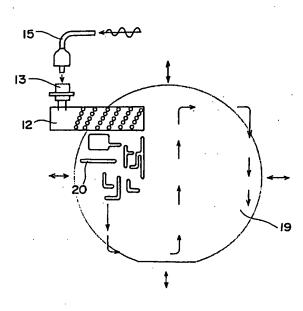
第3図



第 4 図



第 5 図



## 第 4 図

### 平成 2 年 2 月 6 日

#### 特許庁長官

60

- 事件の表示 平成元年特許顕第267575号
- 発明の名称
  マルチ電子源
- 3.補正をする者

事件との関係 特許出額人

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

名 称 (100)キャノン株式会社

代表者 山 路 敬 三

- 4.代理 人 〒180 電話03(358)8840
  - 住 所 東京都新宿区本塩町 12

四谷ニューマンション107

氏 名 (8809) 弁理士 福森久夫

5. 補正命令の日付(発送日)

平成2年 1月30日 .

6.補正の対象

図面 (第4,5図)

7. 補正の内容

別紙の通り

